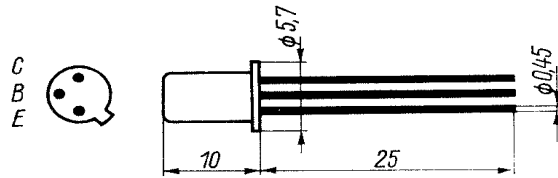


Germanium-pnp-Hochfrequenztransistor der Bauform A 3/25-b nach TGL 11 811 für Verstärker-, Misch- und Oszillatorstufen.



Masse ca. 0,4 g

Wärmewiderstand $R_{thja} \leq 0,5 \text{ grad/mW}$

Grenzwerte; gültig für den Betriebstemperaturbereich

Kollektor-Basis-Spannung	$-U_{CBO}$	$= 15 \text{ V}$
Emitter-Basis-Spannung	$-U_{EBO}$	$= 10 \text{ V}$
Kollektorstrom	$-I_C$	$= 15 \text{ mA}$
Emitterstrom	I_E	$= 15 \text{ mA}$
Basisstrom	$-I_B$	$= 5 \text{ mA}$
Sperrschichttemperatur	ϑ_j	$= 75 \text{ °C}$
Betriebstemperaturbereich		$-25 \text{ °C bis } +65 \text{ °C}$

Statische Kennwerte		Min.	Typ	Max.
Kollektor-Basis-Reststrom	$-I_{CBO}$		$1,5 \mu\text{A}$	$10 \mu\text{A}$
$-U_{CB} = 6 \text{ V}$				
Kollektor-Basis-Reststrom	$-I_{CBO}$		$50 \mu\text{A}$	$500 \mu\text{A}$
$-U_{CB} = 15 \text{ V}$				
Kollektor-Emitter-Reststrom	$-I_{CEO}$		$200 \mu\text{A}$	$600 \mu\text{A}$
$-U_{CE} = 6 \text{ V}$				
Kollektor-Emitter-Reststrom	$-I_{CES}$			$25 \mu\text{A}$
$-U_{CE} = 6 \text{ V}$				
Emitter-Basis-Reststrom	$-I_{EBO}$		$50 \mu\text{A}$	$500 \mu\text{A}$
$-U_{EB} = 10 \text{ V}$				

Dynamische Kennwerte				
Grenzfrequenz	f_{h21b}	7 MHz	10,5 MHz	
$-U_{CE} = 6 \text{ V}$				
$-I_C = 1 \text{ mA}$				
$f = 3 \text{ MHz}$				
Kurzschlußstromverstärkung	h_{21e}	20		
$-U_{CE} = 6 \text{ V}$				
$-I_C = 2 \text{ mA}$				
$f = 1 \text{ kHz}$				
Rauschmaß	F		11 dB	15 dB
$-U_{CE} = 6 \text{ V}$				
$I_C = 0,5 \text{ mA}$				
$= 2 \text{ MHz}$				
$\Delta f = 10 \text{ kHz}$				
$t_g = 1 \text{ k}\Omega$				
vierpolparameter	g_{11e}		0,7 mS	3,3 mS
	C_{11e}		110 pF	250 pF
$-U_{CE} = 6 \text{ V}$	$-g_{12e}$		$2 \mu\text{S}$	$5 \mu\text{S}$
$-I_C = 0,5 \text{ mA}$	$-C_{12e}$		7 pF	14 pF
$f = 2 \text{ MHz}$	$ y_{21e} $	10 mS	16 mS	
	g_{22e}		$30 \mu\text{S}$	$250 \mu\text{S}$
	C_{22e}		29 pF	35 pF

Bestellbeispiel für einen Transistor

Transistor GF 105